



# 日程表 (分科別2)

大分類分科名 中分類分科名	9月16日(月)		9月17日(火)		9月18日(水)		9月19日(木)		9月20日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
1 応用物理学一般										
1.1 応用物理学一般・学際領域					C43 09:00 ~ 11:30					
1.2 教育		P07 16:00 ~ 18:00					C43 09:00 ~ 10:15			
1.3 新技術・複合新領域			C43 09:30 ~ 11:45							
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境						C43 13:00 ~ 17:45				
1.5 計測技術・計測標準		C43 13:00 ~ 16:15								
1.6 超音波		P07 16:00 ~ 18:00		C43 13:00 ~ 17:30						
2 放射線										
2.1 検出器デバイス開発							D61 09:00 ~ 12:00	D61 13:00 ~ 18:00		
2.2 放射線物理学一般・放射線応用・発生装置・新技術									D62 09:00 ~ 12:00	
2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析							P01 13:30 ~ 15:30			
2.4 医用応用			D62 10:00 ~ 11:45		D62 10:00 ~ 11:45					
2.5 放射線誘起蛍光体	D62 10:00 ~ 11:30	D62 13:00 ~ 17:45	B5 09:45 ~ 11:30	B5 13:00 ~ 17:30						
CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.4 イオンビーム一般のコードシェア							D62 13:30 ~ 18:15			
3 光・フォトニクス										
3.1 光学基礎・光学新領域		A32 13:30 ~ 17:15	A32 09:00 ~ 12:00	A32 13:30 ~ 17:00	P01 09:30 ~ 11:30					
3.2 情報フォトニクス・画像工学							P01 09:30 ~ 11:30			
CS.2 3.2 情報フォトニクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェア		A37 13:30 ~ 17:00	A37 09:00 ~ 11:45	A37 13:30 ~ 15:00						
3.3 生体・医用光学							P02 09:30 ~ 11:30	C32 13:00 ~ 16:15	A25 09:00 ~ 11:45	A25 13:30 ~ 15:15
3.4 レーザー装置・材料							P03 09:30 ~ 11:30		A37 10:45 ~ 12:00	A37 13:30 ~ 17:00
CS.3 3.4 レーザー装置・材料、3.13 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェア									A37 09:00 ~ 10:30	
3.5 超高速・高強度レーザー					P02 09:30 ~ 11:30	A25 09:00 ~ 12:00	A25 13:30 ~ 18:00		C301 09:00 ~ 11:30	C301 13:00 ~ 16:30
3.6 レーザープロセス					A25 09:00 ~ 12:00	A25 13:30 ~ 17:45	P04 09:30 ~ 11:30	B2 13:00 ~ 16:45		
3.7 光計測技術・機器							A37 09:15 ~ 12:00	A37 13:30 ~ 17:45	P01 09:30 ~ 11:30	C31 13:00 ~ 14:30
3.8 テラヘルツ全般							P05 09:30 ~ 11:30	A34 13:30 ~ 18:15	A34 09:00 ~ 12:00	A34 13:30 ~ 17:00
3.9 光量子物理・技術					P03 09:30 ~ 11:30		A32 09:00 ~ 11:45	A32 13:30 ~ 18:15		
3.10 フォトリソグラフィ・現象			A34 13:00 ~ 17:45			A34 13:30 ~ 18:00		P01 13:30 ~ 15:30		
CS.4 3.10 フォトリソグラフィ・現象、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェア							A33 09:00 ~ 12:00			
CS.5 3.10 フォトリソグラフィ・現象、3.12 半導体光デバイスのコードシェア					A34 09:30 ~ 12:00					
3.11 ナノ領域光科学・近接場光学					A33 09:00 ~ 11:45	A33 13:00 ~ 18:30		A33 13:30 ~ 18:30	P02 09:30 ~ 11:30	
CS.4 3.10 フォトリソグラフィ・現象、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェア							A33 09:00 ~ 12:00			
3.12 半導体光デバイス					P04 09:30 ~ 11:30		A35 09:00 ~ 12:00			A35 13:30 ~ 16:00
CS.5 3.10 フォトリソグラフィ・現象、3.12 半導体光デバイスのコードシェア					A34 09:30 ~ 12:00					
3.13 光制御デバイス・光ファイバー					A36 09:00 ~ 10:30	A35 13:30 ~ 16:15	P06 09:30 ~ 11:30			
CS.3 3.4 レーザー装置・材料、3.13 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェア									A37 09:00 ~ 10:30	
3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス	A25 09:00 ~ 11:45	A25 13:30 ~ 18:00	C32 09:00 ~ 11:30						P07 09:30 ~ 11:30	
4 JSAP-Optica Joint Symposia 2024										
4.1 Plasmonics and Nanophotonics	B4 09:00 ~ 12:00	B4 13:00 ~ 17:00	A34 09:00 ~ 12:00							
4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics				A25 14:45 ~ 18:15						
4.3 Laser sources and Laser applications			A31 10:45 ~ 12:00	A31 13:30 ~ 17:45						
4.4 Information Photonics										
CS.2 3.2 情報フォトニクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェア		A37 13:30 ~ 17:00	A37 09:00 ~ 11:45	A37 13:30 ~ 15:00						
4.5 Nanocarbon and 2D Materials			A35 09:00 ~ 12:30							
CS.6 4.5 Nanocarbon and 2D Materials、17 ナノカーボン・二次元材料のコードシェア					A35 10:00 ~ 12:00					
4.6 Terahertz Photonics						B2 13:00 ~ 18:15				
4.7 Quantum Optics, Nonlinear Optics and Structured Optics								C43 13:00 ~ 18:00	C43 10:00 ~ 11:30	
4.8 Optica Special Lecture				A25 13:30 ~ 14:30						

# 日程表 (分科別3)

大分類分科名 中分類分科名	9月16日(月)		9月17日(火)		9月18日(水)		9月19日(木)		9月20日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
6 薄膜・表面										
6.1 強誘電体薄膜			B3 09:30 ~ 11:30	B3 13:00 ~ 17:45	B3 10:30 ~ 12:00	P07 16:00 ~ 18:00				
CS.7 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア						B3 13:00 ~ 16:15				
6.2 カーボン系薄膜										
CS.8 6.2 カーボン系薄膜、KS.1 固体量子センサ研究会のコードシェア							B3 09:00 ~ 11:30	B3 13:00 ~ 19:15		P01 13:30 ~ 15:30
6.3 酸化物エレクトロニクス				D61 13:30 ~ 17:15		P02 13:30 ~ 15:30			A41 09:00 ~ 12:00	B3 09:30 ~ 11:30
6.4 薄膜新材料	C31 09:00 ~ 11:30	C31 13:00 ~ 18:00	C301 09:00 ~ 11:30	P01 13:30 ~ 15:30						
6.5 表面物理・真空				P02 13:30 ~ 15:30						
CS.9 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェア		D63 13:00 ~ 17:45								
6.6 フローブ顕微鏡			B4 09:00 ~ 11:15		B4 09:00 ~ 11:30	P03 13:30 ~ 15:30				
CS.10 6.6 フローブ顕微鏡、12.2 評価・基礎物性のコードシェア				B4 13:00 ~ 18:30						
7 ビーム応用										
7.1 X線技術	C43 09:00 ~ 12:00									
7.2 電子ビーム応用			D63 10:00 ~ 11:30	D63 13:00 ~ 17:15						
7.3 微細パターン・微細構造形成技術		P01 13:30 ~ 15:30		D62 13:30 ~ 16:00						
7.4 イオンビーム一般 ※2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析とのコードシェアセッション						D62 13:30 ~ 18:15				
7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術										
CS.9 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェア		D63 13:00 ~ 17:45								
8 プラズマエレクトロニクス										
8.1 プラズマ生成・診断								P02 13:30 ~ 15:30	A32 09:00 ~ 12:00	A32 13:30 ~ 16:30
8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理		P02 13:30 ~ 15:30			A31 09:00 ~ 12:00	A31 13:30 ~ 18:30				
8.3 プラズマナノテクノロジー							A36 09:00 ~ 11:00	P03 13:30 ~ 15:30		
8.4 プラズマライサイエンス								P04 13:30 ~ 15:30	A33 09:00 ~ 11:45	A33 13:30 ~ 17:00
8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野		P03 13:30 ~ 15:30				A32 13:30 ~ 18:45				
8.6 Plasma Electronics English Session		P04 13:30 ~ 15:30				A32 18:45 ~ 19:00				
8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	A41 10:00 ~ 11:30		C41 11:00 ~ 11:45							
8.8 プラズマエレクトロニクス受賞記念講演			C41 09:30 ~ 10:30							
9 応用物性										
9.1 誘電材料・誘電体						C301 13:00 ~ 16:15				
9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート		C301 13:00 ~ 18:30								
9.3 ナノエレクトロニクス							D63 09:00 ~ 11:30	D63 13:00 ~ 15:15		P02 13:30 ~ 15:30
9.4 熱電変換				C301 13:30 ~ 16:45						
CS.11 9.4 熱電変換、22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」のコードシェア					C301 09:00 ~ 11:30					
9.5 新機能材料・新物性								C301 13:30 ~ 17:15		
10 スピントロニクス・マグネティクス										
10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)										
10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	D61 09:00 ~ 11:15	D61 13:00 ~ 16:45								D61 09:00 ~ 11:30
10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術			D61 09:00 ~ 11:30							D61 13:00 ~ 17:00
10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス						D61 13:00 ~ 18:45				
10.5 磁場応用							C301 09:00 ~ 11:00			
11 超伝導										
11.1 基礎物性	A35 09:00 ~ 12:00		C31 09:00 ~ 12:00					C31 09:00 ~ 10:30		
11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長								C31 13:30 ~ 16:15		
11.3 臨界電流、超伝導パワー応用				P03 13:30 ~ 15:30				C31 10:30 ~ 12:00		
11.4 アナログ応用および関連技術						B5 13:00 ~ 17:15				
11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用						B5 09:00 ~ 11:45				
12 有機分子・バイオエレクトロニクス										
12.1 作製・構造制御		P05 13:30 ~ 15:30			C32 09:00 ~ 11:30	D63 13:00 ~ 18:00	A34 09:15 ~ 11:30			
12.2 評価・基礎物性		B6 13:00 ~ 19:30				P04 13:30 ~ 15:30				
CS.10 6.6 フローブ顕微鏡、12.2 評価・基礎物性のコードシェア				B4 13:00 ~ 18:30						
12.3 機能材料・萌芽的デバイス					P05 09:30 ~ 11:30		B6 09:00 ~ 11:30	B6 13:00 ~ 18:15	B6 09:00 ~ 11:30	B6 13:00 ~ 15:30
12.4 有機EL・トランジスタ			B6 09:00 ~ 11:30	B6 13:00 ~ 17:30	B6 09:00 ~ 11:45	B6 13:00 ~ 15:00				
						P08 16:00 ~ 18:00				
12.5 有機・ハイブリッド太陽電池					A41 09:00 ~ 12:00	P09 16:00 ~ 18:00	C302 09:00 ~ 12:00	C302 13:00 ~ 17:00	C302 09:00 ~ 12:00	C302 13:00 ~ 16:00
12.6 ナノバイオテクノロジー				C32 13:00 ~ 16:45		C32 13:00 ~ 16:30			P03 09:30 ~ 11:30	
CS.12 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア							C32 09:00 ~ 11:30			
12.7 医用工学・バイオチップ			C31 13:00 ~ 18:45		C31 09:00 ~ 11:30	C31 13:00 ~ 18:30			P04 09:30 ~ 11:30	
CS.12 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェア							C32 09:00 ~ 11:30			

# 日程表 (分科別4)

大分類分科名 中分類分科名	9月16日(月)		9月17日(火)		9月18日(水)		9月19日(木)		9月20日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13 半導体										
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション									P05 09:30 ~ 11:30	C43 13:00 ~ 16:00
13.2 探索的材料物性・基礎物性		P06 13:30 ~ 15:30		B1 13:00 ~ 16:00	A24 09:00 ~ 11:30					
13.3 絶縁膜技術								B1 13:00 ~ 17:15	P06 09:30 ~ 11:30	
CS.7 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア						B3 13:00 ~ 16:15				
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	B1 09:00 ~ 12:00	B1 13:00 ~ 17:00	B1 09:00 ~ 11:00	P05 16:00 ~ 18:00						
13.5 デバイス/配線/集積化技術		C302 13:00 ~ 18:15		P06 16:00 ~ 18:00	A23 09:00 ~ 12:30					
CS.7 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア						B3 13:00 ~ 16:15				
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス		B2 13:00 ~ 17:15								
13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	A22 09:15 ~ 11:30				P06 09:30 ~ 11:30		C41 09:00 ~ 11:45	C41 13:00 ~ 19:30		
CS.13 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価、15.4 III-V族窒化物結晶のコードシェア		A22 13:00 ~ 19:00								
13.8 光物性・発光デバイス			C302 09:00 ~ 12:00	P07 16:00 ~ 18:00	B1 09:00 ~ 11:30					
13.9 化合物太陽電池						B1 13:00 ~ 18:45		P07 16:00 ~ 18:00		
15 結晶工学										
15.1 バルク結晶成長									P07 09:30 ~ 11:30	D62 13:00 ~ 16:45
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶								P08 16:00 ~ 18:00		
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎					B2 09:15 ~ 11:30		B2 09:15 ~ 11:30	P09 16:00 ~ 18:00		
15.4 III-V族窒化物結晶	A21 09:00 ~ 11:30	A21 13:00 ~ 17:00	C42 09:00 ~ 11:30		C42 09:00 ~ 12:30		C42 09:00 ~ 11:30	C42 13:00 ~ 17:15	A24 09:00 ~ 11:30	C42 13:30 ~ 15:00
CS.13 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価、15.4 III-V族窒化物結晶のコードシェア		A22 13:00 ~ 19:00			P07 09:30 ~ 11:30					
15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶						P10 16:00 ~ 18:00	B5 09:30 ~ 11:45	B5 13:00 ~ 17:15		
15.6 IV族系化合物 (SiC)					C41 09:00 ~ 10:45	P11 16:00 ~ 18:00				
15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥			B2 09:00 ~ 11:30	B2 13:00 ~ 15:30		P12 16:00 ~ 18:00				
16 非晶質・微結晶										
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	C32 09:00 ~ 11:45	C32 13:15 ~ 16:45								
16.2 エナジーハーベスティング				A37 15:30 ~ 16:45				P10 16:00 ~ 18:00		
16.3 シリコン系太陽電池									C32 09:00 ~ 11:30	C32 13:00 ~ 16:00
17 ナノカーボン・二次元材料										
17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	A31 09:00 ~ 12:00	A31 13:30 ~ 19:15								
17.2 グラフェン			P01 09:30 ~ 11:30		A37 09:00 ~ 12:00	A37 13:30 ~ 16:30				
17.3 層状物質							A31 09:00 ~ 12:00	A31 13:30 ~ 18:15	A31 09:00 ~ 12:00	A31 13:15 ~ 17:00
CS.6 4.5 Nanocarbon and 2D Materials、17 ナノカーボン・二次元材料のコードシェア					A35 10:00 ~ 12:00					
21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」										
21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」					A22 09:00 ~ 12:30	A22 13:45 ~ 19:30		P05 13:30 ~ 15:30	A22 09:00 ~ 11:45	A22 13:00 ~ 16:30
CS.11 9.4 熱電変換、22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」のコードシェア					C301 09:00 ~ 11:30					
22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」										
22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」						P05 13:30 ~ 15:30	D62 09:00 ~ 11:30	D62 13:00 ~ 18:00		
23 合同セッションN「インフォマティクス応用」										
23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」			P04 13:30 ~ 15:30	A21 09:00 ~ 12:00	A24 13:30 ~ 17:15				A21 09:00 ~ 11:45	A21 13:30 ~ 16:30